

УДК 669.017 : 537.311.3

## К ТЕОРИИ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ МЕТАЛЛОВ С НЕМАГНИТНЫМИ ПРИМЕСЯМИ В КВАНТУЮЩЕМ МАГНИТНОМ ПОЛЕ

*М. В. Садовский*

Рассмотрена электропроводность металла с немагнитными примесями, помещенного в квантующее магнитное поле. Учтена деформация фононного спектра и движение примесных атомов. Показано, что в кристаллах с тяжелыми примесями образование квазилокального фононного уровня приводит к возникновению нового типа квантовых осциллирующей тензора электропроводности с изменением величины магнитного поля. В аналогичной модели полупроводника или полуметалла предсказывается появление нового типа магнитофононных осцилляций электропроводности.

1. Рассмотрим металл с немагнитными примесями, находящийся в квантующем магнитном поле. Для электронов ограничимся представлением Ландау с циклотронной частотой  $\omega_H = \frac{|e|H}{m}$ , где  $m$  — эффективная масса электронов проводимости. Таким образом, мы сразу пренебрегаем возможными искажениями электронного спектра, возникающими при введении примесей. Взаимодействие электронов с решеткой учтем в борновском приближении. Будем считать, что при внесении примесей типа замещения можно пренебречь изменением силовых констант динамической матрицы решетки. Последнее предположение в металлах хорошо выполнено [1]. Учтем только однофононные неупругие процессы, а также поправки, возникающие в сечении упругого рассеяния из-за многофононных процессов. Тогда гамильтониан задачи записывается в виде

$$H = \sum_n \frac{P_n^2}{2M_n} + \frac{1}{2} \sum_{n,m} \Phi_{nm}^{\alpha\beta} u_n^\alpha u_m^\beta + \sum_v E_v a_v^+ a_v + \frac{1}{V} \sum_{n,v,v',q} V_q^n \langle v | e^{iqr} | v' \rangle \exp\left(-\frac{W_n(q)}{2}\right) \exp(-iqR_n)(1 - iqu_n) a_v^+ a_{v'}, \quad (1)$$

где  $P_n$  — импульс иона в  $n$ -м узле решетки;  $M_n = (1 - \epsilon c_n)M$  — масса иона, причем  $c_n = 1$  в примесном узле,  $c_n = 0$  в нормальном узле;  $u_n$  — смещение иона из положения равновесия  $R_n$ ;  $v \equiv \{n, p_z, x_0\}$  — квантовые числа Ландау;  $E_v \equiv (n + \frac{1}{2})\omega_H + p_z^2/2m$ ;  $\Phi_{nm}^{\alpha\beta}$  — динамическая матрица решетки;  $V_q^n$  — фурье-образ потенциала иона в  $n$ -м узле;  $W_n(q) = (qu_n)^2$  — фактор Дебая—Валлера;  $V$  — нормировочный объем.

2. Теперь можно стандартным образом [2] получить цепочку уравнений для матриц плотности, начиная с уравнения движения для одночастичной матрицы электронов

$$f_{x'x} = \text{Sp } \rho a_x^+ a_{x'}, = \langle a_x^+ a_{x'} \rangle. \quad (2)$$

Цепочку оборвем на втором уравнении, аппроксимируем

$$\langle a_x^\dagger a_x u_n^\alpha u_m^\beta \rangle \simeq \langle a_x^\dagger a_x \rangle \langle u_n^\alpha u_m^\beta \rangle. \quad (3)$$

Получающуюся при этом замкнутую систему можно после некоторых преобразований привести к кинетическому уравнению для одноэлектронной матрицы плотности, усредненной по хаотическим конфигурациям примесных атомов. Для диагональных элементов матрицы плотности имеем:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \bar{f}_x}{\partial t} = & \frac{2\pi c}{V} \sum_{\gamma, \mathbf{q}} |\Delta v(\mathbf{q})|^2 |I_{x\gamma}(\mathbf{q})|^2 \delta(E_x - E_\gamma) \overline{(f_\gamma - f_x)} + \\ & + \frac{2\pi}{V^2} \sum_{m, n, \gamma, \mathbf{q}} |v_0(\mathbf{q})|^2 |I_{x\gamma}(\mathbf{q})|^2 \exp[-i\mathbf{q}(\mathbf{R}_n - \mathbf{R}_m)] \overline{(f_\gamma - f_x)} \times \\ & \times \int_{-\infty}^{\infty} d\omega \overline{\langle q^\alpha u_n^\alpha(t) q^\beta u_m^\beta(t') \rangle} \delta(E_x - E_\gamma + \omega) + \\ & + \frac{2\pi}{V^2} \sum_{m, n, \gamma, \mathbf{q}} 2c_n v_0(\mathbf{q}) \Delta v(\mathbf{q}) |I_{x\gamma}(\mathbf{q})|^2 \exp[-i\mathbf{q}(\mathbf{R}_n - \mathbf{R}_m)] \overline{(f_\gamma - f_x)} \times \\ & \times \int_{-\infty}^{\infty} d\omega \overline{\langle q^\alpha u_n^\alpha(t) q^\beta u_m^\beta(t') \rangle} \delta(E_x - E_\gamma + \omega) + \\ & + \frac{2\pi c}{V} \sum_{\gamma, \mathbf{q}} |\Delta v(\mathbf{q})|^2 |I_{x\gamma}(\mathbf{q})|^2 \overline{(f_\gamma - f_x)} \times \\ & \times \int_{-\infty}^{\infty} d\omega \overline{\langle q^\alpha u_n^\alpha(t) q^\beta u_m^\beta(t') \rangle} \delta(E_x - E_\gamma + \omega). \quad (4) \end{aligned}$$

Здесь черта означает усреднение по примесным конфигурациям;  $c$  — концентрация примесей. Введены обозначения:

$$I_{v v'}(\mathbf{q}) = \langle v | e^{i\mathbf{q}\mathbf{r}} | v' \rangle; \quad (5)$$

$$v_i(\mathbf{q}) = V_{\mathbf{q}}^i \exp \left\langle -\frac{W_n(\mathbf{q})}{2} \right\rangle; \quad (6)$$

$$\Delta v(\mathbf{q}) = v_1(\mathbf{q}) - v_0(\mathbf{q}), \quad (7)$$

где «1» относится к примесному узлу, «0» — к нормальному;  $\langle u_n^\alpha(t) u_m^\beta(t') \rangle_\omega$  — фурье-образ двухвременной корреляционной функции [3] смещений ионов

$$\langle u_n^\alpha(t) u_m^\beta(t') \rangle_\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \langle u_n^\alpha(t) u_m^\beta(t') \rangle e^{i\omega(t-t')} dt. \quad (8)$$

Такое преобразование Фурье по разности времен можно провести, строго говоря, только для системы, находящейся в термодинамическом рав-

новесии. Поэтому предполагаем решетку равновесной. Такого рода средние детально исследовались методом функций Грина в [4]. Были получены следующие выражения для интересующих нас средних:

$$\langle u_n^\alpha(t) u_m^\beta(t') \rangle_\omega = \frac{2\pi}{1 - e^{-\omega/T}} \frac{\delta_{\alpha\beta}}{M} \frac{\text{sign } \omega g(\omega^2)}{R(\omega^2)}, \quad (9)$$

где

$$R(\omega^2) = (1 - \varepsilon\omega^2 J(\omega^2))^2 + (\pi\varepsilon\omega^2 g(\omega^2))^2; \quad (10)$$

$$J(\omega^2) = P \int_0^\infty dz \frac{g(z)}{\omega^2 - z}; \quad (11)$$

$g(\omega^2)$  — функция распределения квадратов частот фононного спектра идеальной решетки;

$$\begin{aligned} & \sum_{nn'} \overline{\exp[i\mathbf{q}(\mathbf{R}_n - \mathbf{R}_{n'})] c_n \langle u_n^\alpha(t) u_{n'}^\beta(t') \rangle_\omega} = \\ & = -\frac{2\pi c N}{1 - e^{-\omega/T}} \sum_j \frac{e_j^\alpha(\mathbf{q}) e_j^\beta(\mathbf{q})}{M} \frac{1}{\pi} \left\{ P \frac{\text{sign } \omega \gamma(\omega^2)}{\omega^2 - \omega_{0j}^2(\mathbf{q})} + \pi \text{sign } \omega \delta(\omega^2 - \omega_{0j}^2(\mathbf{q})) \Delta(\omega^2) \right\}, \quad (12) \end{aligned}$$

где

$$\gamma(\omega^2) = \frac{\pi\varepsilon\omega^2 g(\omega^2)}{R(\omega^2)}; \quad (13)$$

$$\Delta(\omega^2) = \frac{1 - \varepsilon\omega^2 J(\omega^2)}{R(\omega^2)}; \quad (14)$$

$e_j^\alpha(\mathbf{q})$  —  $\alpha$ -я компонента вектора поляризации колебания  $j$ -й ветви фононного спектра;  $\omega_{0j}(\mathbf{q})$  — частота  $j$ -й ветви идеальной решетки;  $N$  — число примесей в кристалле;

$$\begin{aligned} & \sum_{nn'} \overline{\exp[i\mathbf{q}(\mathbf{R}_n - \mathbf{R}_{n'})] \langle u_n^\alpha(t) u_{n'}^\beta(t') \rangle_\omega} = \frac{2\pi N}{1 - e^{-\omega/T}} \sum_j \frac{e_j^\alpha(\mathbf{q}) e_j^\beta(\mathbf{q})}{M} \frac{1}{\pi} \times \\ & \times \frac{\text{sign } \omega \varepsilon c \omega^2 \gamma(\omega^2)}{[\omega^2(1 - \varepsilon c \Delta(\omega^2)) - \omega_{0j}^2(\mathbf{q})]^2 + [\varepsilon c \omega^2 \gamma(\omega^2)]^2}. \quad (15) \end{aligned}$$

Усреднение по примесям проводилось так, чтобы получить интеграл столкновений в линейном по их концентрации приближении. Итак, получаем окончательно:

$$\begin{aligned} \frac{\partial f_\kappa}{\partial t} &= \frac{2\pi c}{V} \sum_{\gamma, \mathbf{q}} |\Delta v(\mathbf{q})|^2 |I_{\kappa\gamma}(\mathbf{q})|^2 \delta(E_\kappa - E_\gamma) (f_\gamma - f_\kappa) + \\ &+ \frac{4\pi^2 N}{MV^2} \sum_{\gamma, \mathbf{q}, j} \int_{-\infty}^{\infty} d\omega \delta(E_\kappa - E_\gamma + \omega) (f_\gamma - f_\kappa) |v_0(\mathbf{q})|^2 |I_{\kappa\gamma}(\mathbf{q})|^2 \times \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & \times \frac{\text{sign } \omega}{1 - e^{-\omega/T}} \frac{1}{\pi} |q^\alpha e_j^\alpha(\mathbf{q})|^2 \delta(\omega^2 - \omega_{0j}^2(\mathbf{q})) + \frac{4\pi^2 Nc}{MV^2} \sum_{\gamma, q, j} \int_{-\infty}^{\infty} d\omega \delta(E_\gamma - E_\gamma + \\
 & + \omega)(f_\gamma - f_\gamma) |v_0(\mathbf{q})|^2 |I_{\kappa\gamma}(\mathbf{q})|^2 \frac{\text{sign } \omega}{1 - e^{-\omega/T}} |q^\alpha e_j^\alpha(\mathbf{q})|^2 \frac{1}{c} \times \\
 & \times \left\{ \frac{1/\pi \omega^2 \varepsilon c \gamma(\omega^2)}{[\omega^2(1 - \varepsilon c \Delta(\omega^2)) - \omega_{0j}^2(\mathbf{q})]^2 + [\varepsilon c \omega^2 \gamma(\omega^2)]^2} - \delta(\omega^2 - \omega_{0j}^2(\mathbf{q})) \right\} + \\
 & + \frac{8\pi^2 Nc}{MV^2} \sum_{\gamma, q, j} \int_{-\infty}^{\infty} d\omega \delta(E_\gamma - E_\gamma + \omega)(f_\gamma - f_\gamma) v_0(\mathbf{q}) \Delta v(\mathbf{q}) |I_{\kappa\gamma}(\mathbf{q})|^2 \times \\
 & \times \frac{\text{sign } \omega}{1 - e^{-\omega/T}} |q^\alpha e_j^\alpha(\mathbf{q})|^2 \frac{1}{\pi} \left\{ P \frac{\gamma(\omega^2)}{\omega^2 - \omega_{0j}^2(\mathbf{q})} + \pi \delta(\omega^2 - \omega_{0j}^2(\mathbf{q})) \Delta(\omega^2) \right\} + \\
 & + \frac{4\pi^2 c}{MV} \sum_{\gamma, q, j} \int_{-\infty}^{\infty} d\omega \delta(E_\gamma - E_\gamma + \omega)(f_\gamma - f_\gamma) |\Delta v(\mathbf{q})|^2 \times \\
 & \times |I_{\kappa\gamma}(\mathbf{q})|^2 \frac{\text{sign } \omega}{1 - e^{-\omega/T}} |q^\alpha|^2 \frac{g(\omega^2)}{R(\omega^2)}. \tag{16}
 \end{aligned}$$

Первые два слагаемые в интеграле столкновений описывают упругое рассеяние на примесях и неупругое рассеяние на идеальной решетке, то есть те механизмы рассеяния, которые обычно и рассматриваются. Последующие члены возникают из-за деформации фононного спектра и движения примесных атомов. Исследование вклада в электропроводность, обусловленного этими членами, и составляет цель настоящей работы.

3. Диссипативный ток проводимости может быть определен из уравнения непрерывности

$$\frac{\partial}{\partial t} [eN(\mathbf{r}, t)] + \text{div } \mathbf{j}_{\text{np}} = 0,$$

где

$$eN(\mathbf{x}, t) = \frac{2e}{(2\pi\alpha)^2} \sum_n \int dp_z \int dx_0 f_{n, p_z x_0} \Phi_n^2 \left( \frac{x - x_0}{\alpha} \right); \tag{17}$$

$$\alpha^2 = \frac{1}{|e|H};$$

$\Phi_n(x)$  — «осцилляторная» часть волновой функции электрона в представлении Ландау. Метод получения уравнения непрерывности из кинетического уравнения был дан в [2, 5]. При этом  $\mathbf{j}_{\text{np}}$  ищется в линейном по термодинамическим силам приближении, так что сразу получается выражение для продольной электропроводности

$$\sigma_{xx} = \frac{e^2}{(2\pi\alpha)^2} \sum_{n, n', q, j} \int dp_z \frac{2\pi c}{V} |\Delta v(q)|^2 F_{n'n} \left( \frac{\alpha^2 q_1^2}{2} \right) \times$$

$$\begin{aligned}
& \times (\alpha^2 q_y)^2 \left( -\frac{\partial f_{n', p_z+q_z}^0}{\partial E} \right) \delta(E_{n, p_z} - E_{n', p_z+q_z}) + \frac{e^2}{(2\pi\alpha)^2} \times \\
& \times \sum_{n, n', q, j} \int dp_z \int_{-\infty}^{\infty} d\omega \delta(E_{n, p_z} - E_{n', p_z+q_z} + \omega) F_{n'n} \left( \frac{\alpha^2 q_{\perp}^2}{2} \right) \times \\
& \times (\alpha^2 q_y)^2 \left( -\frac{\partial f_{n', p_z+q_z}^0}{\partial E} \right) \frac{4\pi^2 N}{MV^2} \frac{\text{sign } \omega}{1 - e^{-\omega/T}} |v_0(\mathbf{q})|^2 \frac{1}{\pi} |q^\alpha e_j^\alpha(\mathbf{q})|^2 \delta(\omega^2 - \omega_{0j}^2(\mathbf{q})) + \\
& + \frac{e^2}{(2\pi\alpha)^2} \sum_{n, n', q} \int dp_z \int_{-\infty}^{\infty} d\omega \delta(E_{n, p_z} - E_{n', p_z+q_z} + \omega) F_{n'n} \left( \frac{\alpha^2 q_{\perp}^2}{2} \right) (\alpha^2 q_y)^2 \times \\
& \times \left( -\frac{\partial f_{n', p_z+q_z}^0}{\partial E} \right) \left[ \frac{4\pi^2 Nc}{MV^2} \frac{\text{sign } \omega}{1 - e^{-\omega/T}} |v_0(\mathbf{q})|^2 \frac{1}{c} |q^\alpha e_j^\alpha(\mathbf{q})|^2 \times \right. \\
& \times \left. \left\{ \frac{\frac{1}{\pi} \omega^2 \varepsilon c \gamma(\omega^2)}{[\omega^2(1 - \varepsilon c \Delta(\omega^2)) - \omega_{0j}^2(\mathbf{q})]^2 + [\varepsilon c \omega^2 \gamma(\omega^2)]^2} - \delta(\omega^2 - \omega_{0j}^2(\mathbf{q})) \right\} + \right. \\
& + \frac{8\pi^2 Nc}{MV^2} \frac{\text{sign } \omega}{1 - e^{-\omega/T}} v_0(\mathbf{q}) \Delta v(\mathbf{q}) \frac{1}{\pi} |q^\alpha e_j^\alpha(\mathbf{q})|^2 \times \\
& \times \left. \left\{ P \frac{\gamma(\omega^2)}{\omega^2 - \omega_{0j}^2(\mathbf{q})} + \pi \delta(\omega^2 - \omega_{0j}^2(\mathbf{q})) \Delta(\omega^2) \right\} + \right. \\
& \left. + \frac{4\pi^2 c}{MV} \frac{\text{sign } \omega}{1 - e^{-\omega/T}} |\Delta v(\mathbf{q})|^2 |q^\alpha|^2 \frac{g(\omega^2)}{R(\omega^2)} \right]. \quad (18)
\end{aligned}$$

Здесь учтен явный вид матричных элементов  $I_{vv'}(\mathbf{q})$ ;  $f_{n, p_z}^0$  — локально равновесное распределение электронов;

$$F_{n'n}(x) = \frac{n!}{n'!} [L_n^{n'-n}(x)] \exp(-x) [x]^{n'-n}; \quad n' \geq n;$$

$$q_{\perp}^2 = q_x^2 + q_y^2; \quad L_n^m = (n!)^{-1} e^x x^{-m} \frac{d^n}{dx^n} (e^{-x} x^{m+n}). \quad (19)$$

Другие продольные кинетические коэффициенты могут быть легко получены методами, описанными в [2, 5]. Поперечные потоки в большинстве случаев определяются холловскими токами и учет столкновительных поправок к ним существен только в веществе с равной концентрацией электронов и дырок [6].

4. Далее рассмотрим только поправку к  $\sigma_{xx}$ , возникающую от деформации фононного спектра и движения примесей, поскольку остальная часть  $\sigma_{xx}$  подробно обсуждалась в многочисленных работах. Предположим, для простоты, изотропный закон дисперсии для фононов

идеальной решетки. В металле, кроме того,  $\left(-\frac{\partial f_{n,p_z}^0}{\partial E}\right) \simeq \delta(\zeta - E_{n,p_z})$ , где  $\zeta$  — химический потенциал. Тогда интересующий нас вклад в  $\sigma_{xx}$  принимает вид

$$\begin{aligned} \Delta\sigma_{xx} = & \frac{N|e|cm}{8\pi^3MVH} \sum_{n,n'} \int_0^\infty \frac{d\omega^2}{2\omega} \int dq_z \int dq_\perp q_\perp^3 F_{n'n} \left(\frac{\alpha^2 q_\perp^2}{2}\right) (q_\perp^2 + q_z^2) \times \\ & \times \frac{[1 + 2n(\omega)]}{\left| \sqrt{\left[\zeta - \left(n' + \frac{1}{2}\right)\omega_H\right] \left[\zeta - \left(n + \frac{1}{2}\right)\omega_H - \omega\right]} \right|} \times \\ & \times \delta \left[ q_z \pm \sqrt{2m \left[\zeta - \left(n + \frac{1}{2}\right)\omega_H - \omega\right]} \mp \sqrt{2m \left[\zeta - \left(n' + \frac{1}{2}\right)\omega_H\right]} \right] \times \\ & \times \left\{ |v_0(\mathbf{q})|^2 \frac{1}{c} \left[ \frac{\omega^2 \varepsilon c \gamma(\omega^2)}{[\omega^2(1 - \varepsilon c \Delta(\omega^2)) - \omega_0^2(\mathbf{q})]^2 + [\varepsilon c \omega^2 \gamma(\omega^2)]^2} - \right. \right. \\ & \left. \left. - \pi \delta(\omega^2 - \omega_0^2(\mathbf{q})) \right] + 2v_0(\mathbf{q}) \Delta v(\mathbf{q}) \left[ P \frac{\gamma(\omega^2)}{\omega^2 - \omega_0^2(\mathbf{q})} + \right. \right. \\ & \left. \left. + \pi \delta(\omega^2 - \omega_0^2(\mathbf{q})) \Delta(\omega^2) \right] + \frac{\pi V}{N} |\Delta v(\mathbf{q})|^2 \frac{g(\omega^2)}{R(\omega^2)} \right\}, \quad (20) \end{aligned}$$

где  $n(\omega) = (e^{\omega/T} - 1)^{-1}$ .

Как показано в [4], функция  $\gamma(\omega^2)$  имеет резонансный характер вблизи частоты т. н. квазилокального уровня, образующегося в кристаллах с тяжелыми примесями ( $|\varepsilon| \gg 1$ ),

$$\gamma(\omega^2) \approx \frac{\varepsilon}{|\varepsilon|} \frac{\omega_*^2 \lambda}{(\omega^2 - \omega_*^2)^2 + \lambda^2}, \quad (21)$$

где  $\omega_*$  — частота квазилокального уровня

$$\omega_*^2 = \frac{\omega_D^2}{|\varepsilon|} \frac{1}{\left\langle \frac{\omega_D^2}{\omega^2} \right\rangle} \ll \omega_D^2; \quad (22)$$

$$\lambda = \pi d \left( \frac{\omega_*}{\omega_D} \right)^3 \frac{1}{\left\langle \frac{1}{\omega^2} \right\rangle} \ll \omega_*^2. \quad (23)$$

Здесь  $\omega_D$  — дебаевская частота;  $\langle \dots \rangle$  — означает среднее по спектру с плотностью  $g(\omega^2)$ ;  $d$  — коэффициент из формулы  $g(\omega^2) = \frac{d \sqrt{\omega^2}}{\omega_D^3}$ , справедливой для низкочастотной части спектра. В модели Дебая  $d=3/2$ , тогда имеем:

$$\omega_*^2 = \frac{\omega_D^2}{3|\varepsilon|}; \quad (24)$$

$$\lambda = \frac{\pi}{6} \frac{\omega_* \omega_{\perp}}{|\varepsilon|}. \quad (25)$$

Аппроксимируя подынтегральное выражение в (20) его значением в резонансе, проведем интегрирование по области частот  $\sim \lambda^{1/2}$  (ширина резонанса). Это соответствует тому, что при  $|\varepsilon| \gg 1$  все примесные атомы колеблются в узкой области частот вокруг  $\omega_*$  и только эта область дает вклад в  $\Delta\sigma_{xx}$ . Кроме того, для простоты можем пренебречь перенормировкой частот  $\Delta(\omega^2)$ , тем более что это не повлияет существенно на результат. Тогда получаем

$$\begin{aligned} \Delta\sigma_{xx} = & \frac{N|e|cm}{16\pi^3MVH} \sum_{n,n'} \int dq_z \int dq_{\perp} q_{\perp}^3 \times \\ & \times \frac{F_{n'n} \left( \frac{\alpha^2 q_{\perp}^2}{2} \right) (q_{\perp}^2 + q_z^2)}{\left| \sqrt{\left[ \zeta - \left( n' + \frac{1}{2} \right) \omega_H \right] \zeta - \left( n + \frac{1}{2} \right) \omega_H - \omega_*} \right|} \times \\ & \times \delta \left[ q_z \pm \sqrt{2m \left[ \zeta - \left( n + \frac{1}{2} \right) \omega_H - \omega_* \right]} \right] \mp \\ & \mp \sqrt{2m \left[ \zeta - \left( n' + \frac{1}{2} \right) \omega_H \right]} \left[ 1 + 2n(\omega_*) \right] \times \\ & \times \left\{ |v_0(\mathbf{q})|^2 \frac{1}{c\omega_*} \left[ \frac{c|\varepsilon|\omega_*^4}{[\omega_*^2 - \omega_0^2(\mathbf{q})]^2 + \left[ \varepsilon c \frac{\omega_*^4}{\lambda} \right]^2} - \pi\delta(\omega_*^2 - \omega_0^2(\mathbf{q})) \right] + \right. \\ & \left. + 2v_0(\mathbf{q})\Delta v(\mathbf{q}) \frac{\omega_*}{\omega_0^2(\mathbf{q}) - \omega_*^2} + \frac{V}{N|\varepsilon|} |\Delta v(\mathbf{q})|^2 \frac{1}{\omega_*} \right\}. \quad (26) \end{aligned}$$

Отсюда видно, что при

$$\zeta - \left( n' + \frac{1}{2} \right) \omega_H = 0; \quad (27)$$

$$\zeta - \left( n + \frac{1}{2} \right) \omega_H - \omega_* = 0. \quad (28)$$

имеем расходящееся выражение для  $\Delta\sigma_{xx}$ . В случае (27) аналогичная расходимость имеется и в выражениях для вклада в  $\sigma_{xx}$ , обусловленного упругим рассеянием на примесях и неупругим рассеянием на идеальной решетке [7]. В случае (28) расходимость имеется только в  $\Delta\sigma_{xx}$ . Поэтому в квантовом пределе  $T \ll \omega_H < \zeta$  в  $\Delta\sigma_{xx}$  возникает дополнительный тип осцилляций при изменении магнитного поля. Период обычных осцилляций  $\sigma_{xx}$

$$\Delta \left( \frac{1}{H} \right) = \frac{|e|}{\xi m}. \quad (29)$$

Для дополнительных осцилляций, возникающих из-за появления квазилокального уровня,

$$\Delta\left(\frac{1}{H}\right) = \frac{|e|}{(\xi - \omega_*)m}. \quad (30)$$

Максимальная амплитуда обычных осцилляций определяется столкновительным уширением электронных уровней и равна по порядку величины [7]:

$$\sigma_{xx\max} \sim \sigma_{xx}^0 \left(\frac{\omega_H}{\xi}\right)^{1/2} \sqrt{\omega_H \tau_c}, \quad (31)$$

где  $\sigma_{xx}^0$  — гладкая часть  $\sigma_{xx}$ ;  $\tau_c$  — время свободного пробега. Величина максимальной амплитуды  $\Delta\sigma_{xx}$  определяется главным образом уширением квазилокального уровня, так что аналогично

$$\Delta\sigma_{xx\max} \sim \Delta\sigma_{xx}^0 \left(\frac{\omega_H}{\xi}\right)^{1/2} \sqrt{\frac{\omega_H}{\lambda^{1/2}}}. \quad (32)$$

Отдельные максимумы должны быть различимы, так как можно убедиться, что расстояние между ними значительно превышает их ширину.

В кристаллах с легкими примесями возникает дискретный локальный уровень в фононном спектре и можно убедиться, что  $\Delta\sigma_{xx}$  описывается аналогичными формулами. Однако ввиду того что  $\omega_{\text{лок}} > \omega_D$ , при низких температурах  $T \ll \omega_D$  возбуждены только его нулевые колебания и соответствующая  $\Delta\sigma_{xx}$  мала.

В случае невырожденных носителей тока (полупроводники и полуметаллы) рассмотрение выражения (18) с использованием для электронов больцмановской статистики приводит к выражению

$$\begin{aligned} \Delta\sigma_{xx} = & \frac{N|e|cm}{8\pi^3 MVHT} \sum_{n, n'} \int_0^\infty dp_z \int dq_z dq_\perp q_\perp^3 (q_\perp^2 + q_z^2) F_{n'n} \left(\frac{\alpha^2 q_\perp^2}{2}\right) \times \\ & \times \exp\left(-\frac{\left(n' + \frac{1}{2}\right)\omega_H - \xi}{T}\right) \exp\left(-\frac{(p_z + q_z)^2}{2mT}\right) \times \\ & \times \frac{[1 + 2n(\omega_*)]}{\left|\sqrt{p_z^2 + 2m(n - n')\omega_H - 2m\omega_*}\right|} K(q) \times \\ & \times \delta\left[q_z + p_z \mp \sqrt{p_z^2 + 2m(n - n')\omega_H - 2m\omega_*}\right], \quad (33) \end{aligned}$$

где  $K(q)$  — функция, стоящая в фигурных скобках в формуле (26). Видно, что при выполнении условия

$$(n - n')\omega_H = \omega_* \quad (34)$$

имеющийся в (33) интеграл по  $p_z$  логарифмически расходится ( $\sim \ln \sqrt{2m[(n - n')\omega_H - \omega_*]}$ ). Таким образом, благодаря квазилокальным колебаниям примесей возникает новый тип магнитофононных осцилляций  $\sigma_{xx}$ , обусловленных резонансными переходами электронов между уровнями Ландау. Период этих осцилляций

$$\Delta\left(\frac{1}{H}\right) = \frac{|e|}{m\omega_*}. \quad (35)$$



Амплитуда осцилляций опять определяется уширением квазилокального уровня, а расстояние между максимумами превышает их ширину.

В ультраквантовом пределе  $\omega_H > \xi \gg T$  формула (26) преобразуется к виду, в котором выделена характерная зависимость от магнитного поля и температуры,

$$\Delta\sigma_{xx} \approx \frac{Ne^2 mcK \left(\frac{1}{\alpha}\right)}{2\sqrt{2\pi^3} MV \sqrt{|e|H}} [1 + 2n(\omega_*)] \frac{1}{\left|\xi - \frac{|e|H}{2m}\right|}. \quad (36)$$

В случае больцмановской статистики имеем аналогичную оценку

$$\Delta\sigma_{xx} \approx \frac{Ne^2 mcK \left(\frac{1}{\alpha}\right)}{4\sqrt{2\pi^3} MV \sqrt{|e|H}} \exp\left(-\frac{\xi + \omega_*}{T}\right) \exp\left(-\frac{|e|H}{2mT}\right) \sqrt{\frac{\pi}{\lambda T}} [1 + 2n(\omega_*)]. \quad (37)$$

Последние формулы претендуют только на выявление качественных зависимостей.

В заключение автор хотел бы выразить глубокую благодарность докт. физ.-мат. наук П. С. Зырянову за предложенную тему и руководство работой.

Институт физики металлов  
АН СССР

Поступила в редакцию  
25 августа 1969 г.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Каган Ю. М., Жернов А. П. ЖЭТФ, 1966, 50, 1107.
2. Зырянов П. С., Гусева Г. И. УФН, 1968, 95, 565.
3. Бонч-Бруевич В. Л., Тябликов С. В. Метод функций Грина в статистической механике, М., Физматгиз, 1961.
4. Каган Ю. М. Сб. Физика кристаллов с дефектами. Материалы школы теоретической физики в Телави, Тбилиси, 1966.
5. Зырянов П. С. ЖЭТФ, 1964, 47, 1378; ФММ, 1963, 16, 11.
6. Гусева Г. И., Зырянов П. С. Phys. stat. sol., 1968, 25, 775.
7. Adams E., Holstein T. J. Phys. Chem. Sol., 1959, 10, 254.